

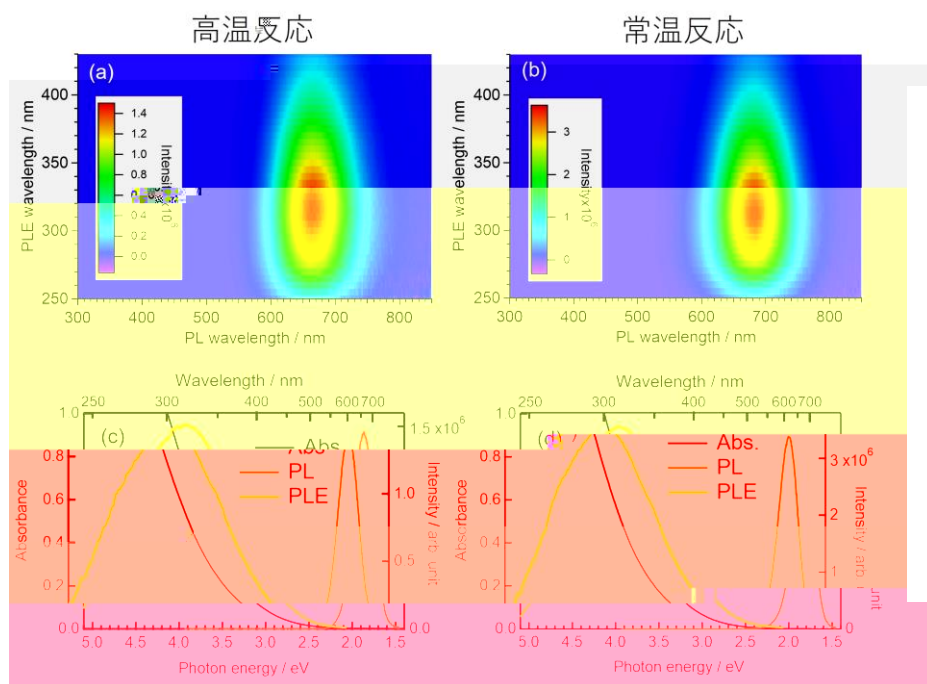
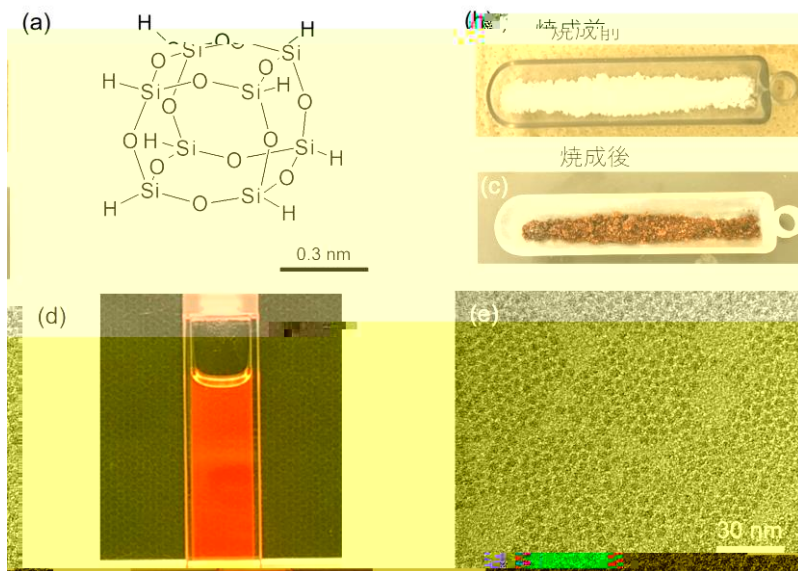
*NEWS RELEASE*



①

②

-



SiQD	Si-H 基 (%)	Si-H <sub>x</sub> 基 (%)	Si-O-Si 基 (%)	Si-C 基 (%)	Si-Cl 基 (%)	ダングリングボンド (%)
高温化学修飾反応	65±5	16±1	28±6	6.8±1	0.0	8.2×10 <sup>-3</sup>
		=Si-H <sub>1</sub>				
		24±2				
		=Si-H <sub>2</sub>				
25±1	-Si-H <sub>3</sub>					
常温化学修飾反応	73±2	12±1	20±1	3.3±0.5	3.5±0.2	1.6×10 <sup>-3</sup>
		=Si-H <sub>1</sub>				
		32±1				
		=Si-H <sub>2</sub>				
29±1	-Si-H <sub>3</sub>					

